

Presseinformation

Höchste Energieeffizienz für Anwendungen wie Elektrowerkzeuge oder E-Bikes mit begrenztem Bauraum; neue MOSFETs von Infineon

München, 20. Juli 2015 – Die Infineon Technologies AG hat eine neue, besonders kompakte Produktfamilie der StrongIRFET™-MOSFETs am Markt eingeführt. Die neuen Leistungsbauelemente sind für Gleichspannungsanwendungen einschließlich batteriebetriebener Schaltungen und Gleichstrommotoren (bürstenbehaftet oder bürstenlos) ausgelegt. Für Endanwendungen wie [Elektrowerkzeuge](#) oder [Gartengeräte](#), [leichte Elektrofahrzeuge](#), Drohnen und [E-Bikes](#) bieten die neuen MOSFETs höchste Energieeffizienz bei reduziertem Platzbedarf. Das kompakte Medium Can DirectFET™-Gehäuse mit einem optimierten Layout macht dies möglich.

„Die hohe Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der DirectFET-Gehäusetechnologie werden durch das neue Layout mit reduziertem thermischen Widerstand nochmals gesteigert. In Kombination mit einem robusten Silizium-Chip verbessern die neuen StrongIRFET DirectFET-MOSFETs die Systemabmessung sowie die Effizienz und verringern die Kosten. Damit sind sie prädestiniert für alle platzkritischen Applikationen, für die Hersteller und Anwender einen hohen Wirkungsgrad fordern,“ sagte Stephane Ernoux, Product Marketing, Power Management and Multimarket Business, Infineon Technologies.

Die neuen StrongIRFET-Bauelemente sind in einem Medium Can DirectFET-Gehäuse untergebracht. Das Gehäuse mit der Möglichkeit zur doppelseitigen Kühlung liefert sowohl höchste Leistungsdichte als auch ein ausgezeichnetes thermisches Management. Indem das Gate-Pad bei diesen neuen Bausteinen in der Ecke des Chips platziert wurde, ist der Source-Kontaktbereich deutlich vergrößert. Damit wurde der thermische Widerstand gegenüber der Leiterplatte im Vergleich zu den bisherigen DirectFET-Gehäusen nochmals reduziert – für eine höhere Effizienz und einen erweiterten Einsatzbereich.

Die neuen Bauelemente sind im Bereich von 40 V bis 75 V verfügbar. Sie bieten die bekannten Leistungsmerkmale der StrongIRFET-Familie, wie geringer Durch-

lasswiderstand ($R_{DS(on)}$) für geringe Leitungsverluste, hohe Stromtragfähigkeit und robustes Silizium für hohe Systemzuverlässigkeit. Die Produktfamilie wird in einem umweltfreundlichen, komplett bleifreien, ROHS-konformen Gehäuse geliefert.

Spezifikationen

Bauteil-Nummer	Gehäuse	Outline	V_{DS} (V)	$R_{DS(on)}$ (m Ω) Typ/Max @ 10 V	Id (A)	Qg (nC)
IRF7480MTRPBF	Medium Can DirectFET	ME	40	0,9 / 1,2	217	123
IRF7483MTRPBF	Medium Can DirectFET	MF	40	1,7 / 2,3	135	81
IRF60DM206	Medium Can DirectFET	ME	60	2,2 / 2,9	130	133
IRF7580MTRPBF	Medium Can DirectFET	ME	60	2,9 / 3,6	114	120
IRF7780MTRPBF	Medium Can DirectFET	ME	75	4,5 / 5,7	89	124

Verfügbarkeit

Die neuen MOSFETs sind in Produktionsstückzahlen ab sofort verfügbar. Weitere Informationen zu den StrongIRFET Medium Can DirectFET- MOSFETs sind erhältlich unter www.infineon.com/strongirfet.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleitern. Produkte und Systemlösungen von Infineon helfen bei der Bewältigung von drei zentralen Herausforderungen der modernen Gesellschaft: Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Mit weltweit rund 29.800 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2014 (Ende September) einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro. Im Januar 2015 übernahm Infineon den US-Konzern International Rectifier Corporation, führend in Technologien für Power Management, mit einem Umsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar (Geschäftsjahr 2014, per 29. Juni) und rund 4.200 Beschäftigten.

Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com

Für die Fachpresse
Informationsnummer INFPMM201507.071d

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Fabian Schiffer
Tel.: +49 89 234-25869
fabian.schiffer@infineon.com

Investor Relations:

Tel.: +49 89 234-26655,
investor.relations@infineon.com

Diese Presseinformationen finden Sie online unter www.infineon.com/presse

Follow us:

twitter.com/Infineon – facebook.com/Infineon – plus.google.com/+Infineon

